Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0403U002500

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-07-2003

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Данилець Євген Валентинович
2. Danilets Eugane Valentinovech

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.27.06

Назва наукової спеціальності: Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 20-06-2003

Спеціальність за освітою: 8.090804.01

Місце роботи здобувача: Херсонський державний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05480298

Місцезнаходження: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 67.052.03

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Херсонський державний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05480298

Місцезнаходження: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Тема дисертації:

1. Позиційно-чутливі фотоприймачі на основі Si і епітаксійних структур GaAs (отримання, властивості, застосування)

2. Position-sensitive photodetectors based on Si and epitaxial structures of GaAs (receiving, properties, application)

Реферат/анотація:

1. Об'єкт - явище виникнення фото-ЕРС, яка лінійно залежить від координати світлової плями на поверхні фотоприймача; мета - розробка технології виготовлення ПЧФ із поліпшеними параметрами як на основі традиційних напівпровідникових матеріалів, так і з використанням напівпровідникових структур, що раніше не застосовувалися для виготовлення ПЧФ, а також дослідження їх характеристик і розширення областей їх застосування; методи - оптичні та електричні, математичне моделювання з використанням ЕОМ; новизна - вперше запропоновано оригінальну технологію виготовлення розділяючої канавки для діагонально-розділених кремнієвих ПЧФ з використанням анізотропного травлення, вперше виготовлені ПЧФ на епітаксійних структурах GaAs:Si, вперше проведено чисельне моделювання позиційної характеристики двокоординатних, вперше виготовлені і експериментально досліджені ПЧФ на основі легованої надгратки в системі p-GaAs-n-GaAs; результати - розроблена технологія виготовлення ПЧФ з поліпшеними параметрами

як на основі традиційнихнапівпровідникових матеріалів, так і з використанням напівпровідникових структур, що раніше не застосовувались для виготовлення ПЧФ; галузь впровадження - автоматичні системи контролю

2. The object is phenomenon of appearance of photo-EMF witch is linearly depends on light spot coordinate on the surface of photoreceiver; the aim is development of technology of production of positional sensitive photoreceivers (PSP) with improved characteristics, using traditional semiconductor materials and semiconductor structures witch were never used for PSP production, investigation of their main characteristic and proposition of some areas of their usage; the methods are optical and electrical, mathematical modeling using computer; the new approach lies in original technology of production of the dividing groove for the PSP based on the transverse photoeffect, the production of PSP on structures GaAs:Si and superlattice GaAs, mathematical modeling of position characteristic of the two-coordinate PSP; the result is technology of production of PSP with improved characteristics, using traditional semiconductor materials and semiconductor structures witch were never used for PSP production; the fieldof developing is automatic systems of control

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кучерук О.Д.
2. Kucheruk A.D.

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дмитрук М.Л.

2. Дмитрук М.Л.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кулюткіна Т.Ф.

2. Кулюткіна Т.Ф.

Кваліфікація: к.т.н., 05.27.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Марончук І.Є

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Марончук І.Є

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.